

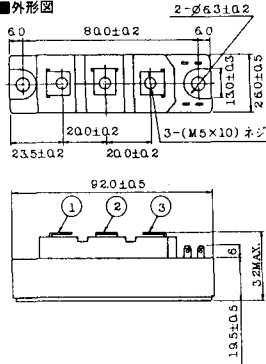
サイリスタ・モジュール

東 芝

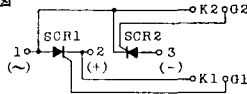
MSG60()41

- 電力制御用
- 絶縁耐圧 MSG60G41~MSG60L41 2000V
MSG60N41~MSG60U41 2500V

■外形図



■接続図



■最大定格

記号	G	J	L	N	Q	S	U		単位
V_{RRM}	500	720	960	1200	1440	1600	1750		V
V_{DRM}	400	600	800	1000	1200	1400	1600		V
V_{TRM}	400	600	800	1000	1200	1400	1600		V
$I_{T(AV)}$	30 (单相半波, $T_r=84^\circ\text{C}$)								
$I_{T(RMS)}$	47								
I_{TSM}	600/660:50Hz:60Hz, 正弦半波1サイクル波高値)								
$I^2 \cdot t$	1800								
di/dt	100 ($V_D = \frac{1}{2} V_{DRM}$)								
P_{GM}	5								
$P_{GM(AV)}$	0.5								
V_{GDM}	5								
I_{GFM}	2								
T_j	-40 ~ +125								
T_{stg}	-40 ~ +125								

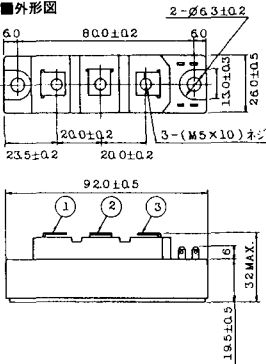
■電気的特性

記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
I_{RRM}	$T_j = 125^\circ\text{C}, V_D = V_{RRM}$			6	mA
I_{DRM}	$T_j = 125^\circ\text{C}, V_D = V_{DRM}$			6	mA
V_{TM}	$T_a = 25^\circ\text{C}, I_{TM} = 100\text{A}$			1.5	V
V_{GT}	$T_a = 25^\circ\text{C}, V_D = 6\text{V}$			1.5	V
I_{GT}	$R_L = 10\Omega$			80	mA
V_{GD}	$T_r = 125^\circ\text{C}, V_D = \frac{1}{2} V_{DRM}$	0.25			V
I_{GD}					mA
dv/dt	$T_r = 125^\circ\text{C}, V_D = \frac{1}{2} V_{DRM}$	500			V/ μs
I_H	$T_a = 25^\circ\text{C}, R_L = 100\Omega$			150	mA
R_{th}	接合部-ケース間			0.8	$^\circ\text{C}/\text{W}$

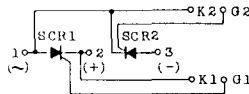
MSG100()41

- 電力制御用
- 絶縁耐圧 MSG100G41~MSG100L41 2000V
MSG100N41~MSG100U41 2500V

■外形図



■接続図



■最大定格

記号	G	J	L	N	Q	S	U		単位
V_{RRM}	500	720	960	1200	1440	1600	1750		V
V_{DRM}	400	600	800	1000	1200	1400	1600		V
V_{TRM}	400	600	800	1000	1200	1400	1600		V
$I_{T(AV)}$	50 (单相半波, $T_r=86^\circ\text{C}$)								
$I_{T(RMS)}$	79								
I_{TSM}	1000/1100 (50Hz:60Hz, 正弦半波1サイクル波高値)								
$I^2 \cdot t$	5000								
di/dt	100 ($V_D = \frac{1}{2} V_{DRM}$)								
P_{GM}	5								
$P_{GM(AV)}$	0.5								
V_{GDM}	5								
I_{GFM}	2								
T_j	-40 ~ +125								
T_{stg}	-40 ~ +125								

■電気的特性

記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
I_{RRM}	$T_j = 125^\circ\text{C}, V_D = V_{RRM}$			10	mA
I_{DRM}	$T_j = 125^\circ\text{C}, V_D = V_{DRM}$			10	mA
V_{TM}	$T_a = 25^\circ\text{C}, I_{TM} = 150\text{A}$			1.5	V
V_{GT}	$T_a = 25^\circ\text{C}, V_D = 6\text{V}$			1.5	V
I_{GT}	$R_L = 10\Omega$			80	mA
V_{GD}	$T_r = 125^\circ\text{C}, V_D = \frac{1}{2} V_{DRM}$	0.25			V
I_{GD}					mA
dv/dt	$T_r = 125^\circ\text{C}, V_D = \frac{1}{2} V_{DRM}$	500			V/ μs
I_H	$T_a = 25^\circ\text{C}, R_L = 100\Omega$			150	mA
R_{th}	接合部-ケース間			0.5	$^\circ\text{C}/\text{W}$